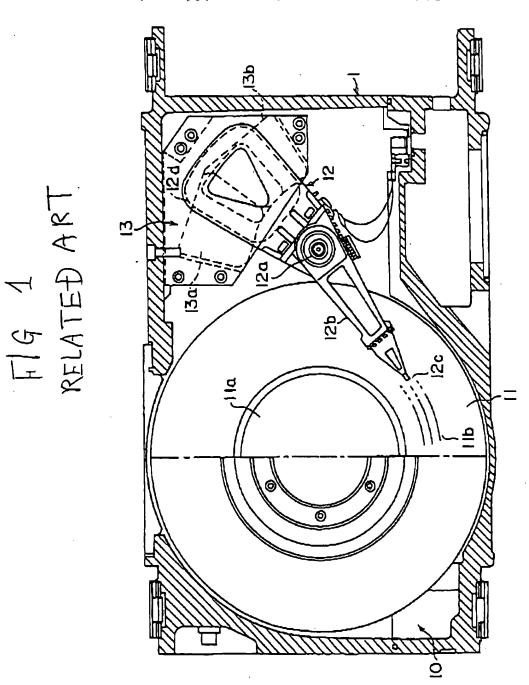
整理番号= 0 9 4 0 4 2 8 【書類名】 四面

[図1]

D L (No. 3313 P. 79/94 F00099

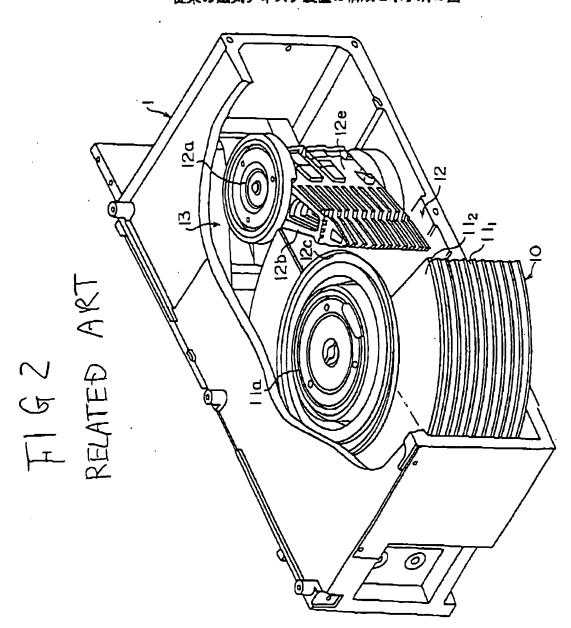
## 従来の磁気ディスク装置の構成を示す図



for first than soon than the first form the <u>|</u>=5 THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

[图2]

## 従来の磁気ディスク装置の構成を示す別の図



整理番号 9 4 0 4 2 8

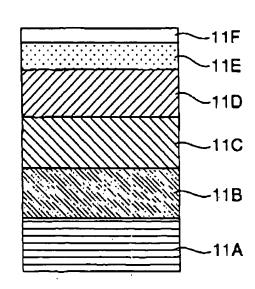
(3)

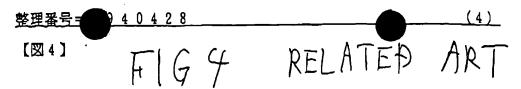
[図3]

FIG3 RELATED ART

従来の磁気ディスク装置で使われている磁気ディスクの 断面構造を示す図

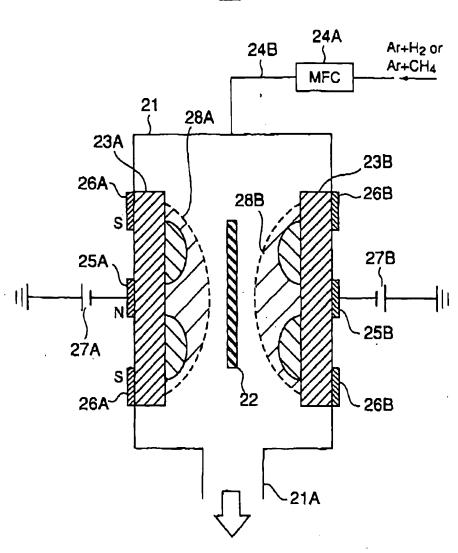
<u>11</u>

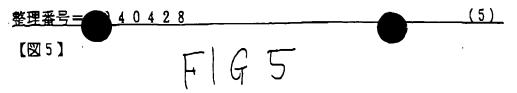




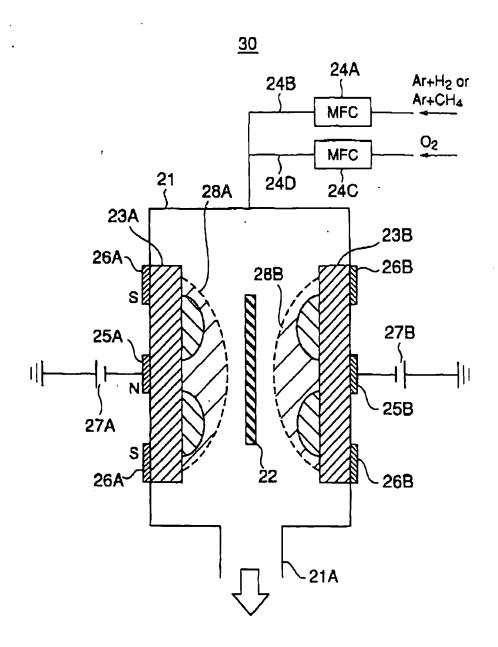
従来の磁気ディスクの製造に使われている DCマグネトロンスパッタ装置の構成を示す図

<u>20</u>





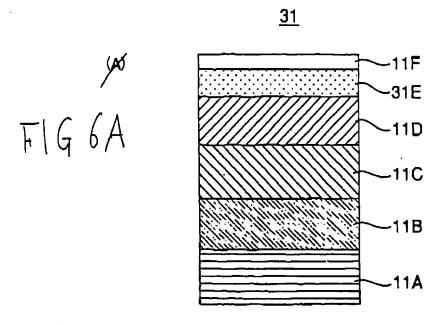
本発明の一実施例による磁気ディスクの製造において使われる DCマグネトロンスッパタ装置の構成を示す図

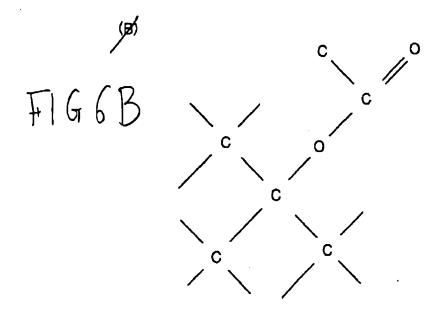


The good that they had been said



(A)、(B)は、それぞれ本発明の一実施例により製造された磁気ディスクの断面図、および前記磁気ディスク中のDLC膜の構造式を示す図

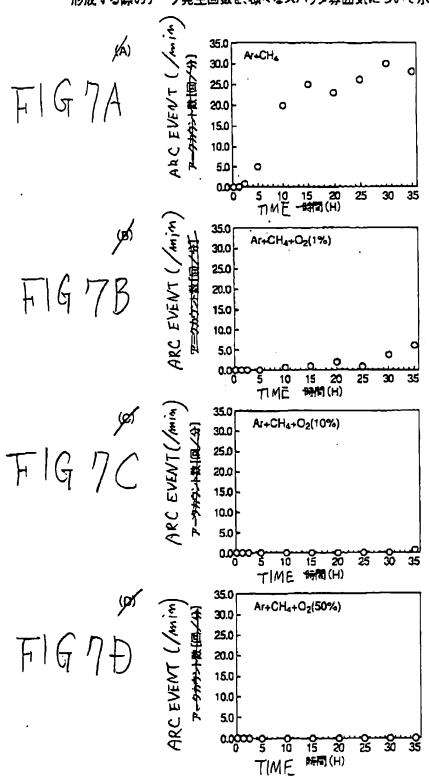




940428 整理番号ラ

[図7]

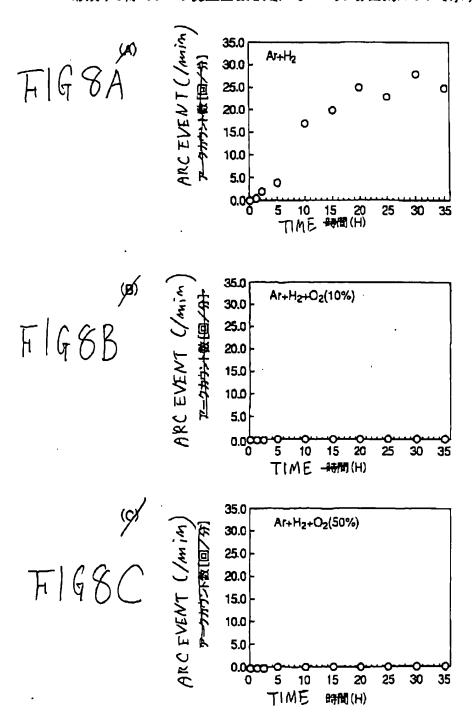
(A)~(D)は、本発明の一実施例による磁気ディスクの製造において、 DLC膜をAr/CHaをベースとするスパッタガス中におけるスッパタリングにより 形成する際のアーク発生回数を、様々なスパッタ雰囲気について示す図



ioj Lj ij1 Ľ IJ U (7) 1 ļab C lab I)

**整理番号** 9 4 0 4 2 8 (8)

(A)~(C)は、本発明の一実施例による磁気ディスクの製造において、 DLC膜をAr/H2をベースとするスパッタガス中におけるスッパタリングにより 形成する際のアーク発生回数を、様々なスパッタ雰囲気について示す図



fuell they good they they they inst

Hall H H H H

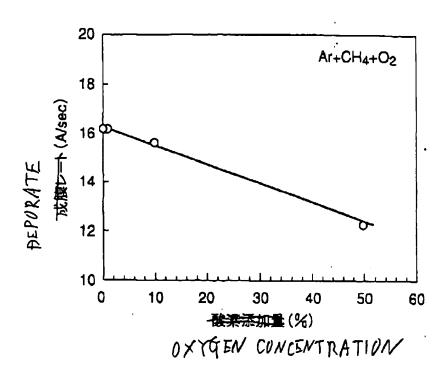
(9)

整理番号= 9 4 0 4 2 8

[図9]

FIG 9

本発明の一実施例による磁気ディスクの製造において、 DLC膜中に含まれるO原子の割合を示す図



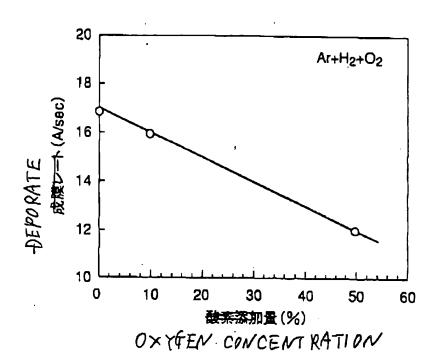
(10)

整理番号= 940428

[图10]

F1910

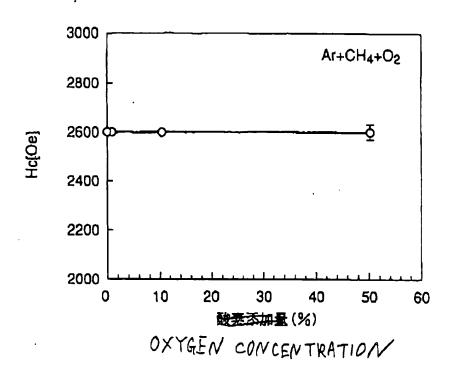
本発明の一実施例による磁気ディスクの製造において、 DLC膜中に含まれるO原子の割合を示す別の図



整理番号 9 4 0 4 2 8 【図 1 1】

[G ]

本発明の一実施例による磁気ディスクの製造において、DLC膜の形成を様々な 酸素濃度のスパッタ雰囲気中において行った場合の磁性膜の磁化特性を示す図

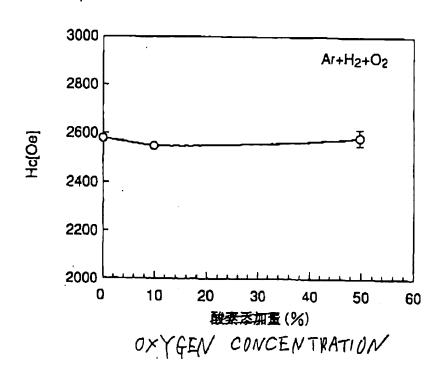


(12)

**整理番号** 9 4 0 4 2 8

FIG12

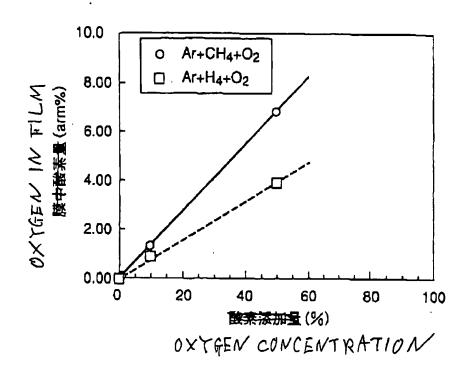
本発明の一実施例による磁気ディスクの製造において、DLC膜の形成を様々な酸素 濃度のスパッタ雰囲気中において行った場合の磁性膜の磁化特性を示す別の図



整理番号 9 4 0 4 2 8 【図 1 3】 (13)

F1913

スパッタ雰囲気とスパッタリングにより形成されるDLC膜中の 酸素濃度との関係を示す図



整理番号

940711

F1914

午午17年11-312728 F00099

本発明の第1実施例による磁気ディスク装置の構成を示す図

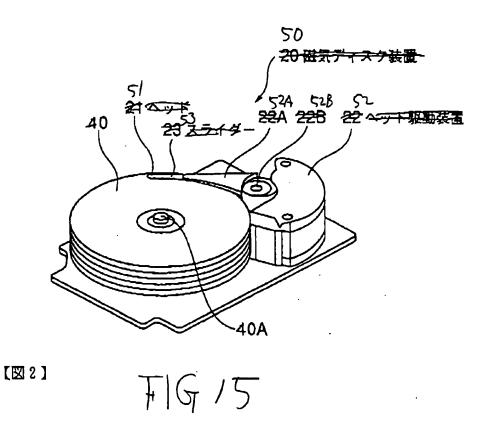
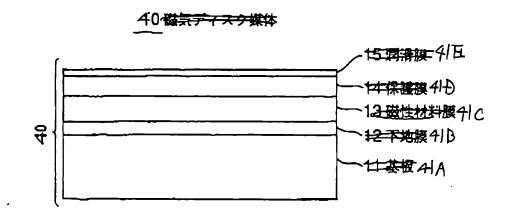


図1の磁気ディスク装置で使われる磁気ディスクの断面図



[図3]

(A)~(C)は、本発明の第2実施例による、光架橋反応装置の 構成を示す図

